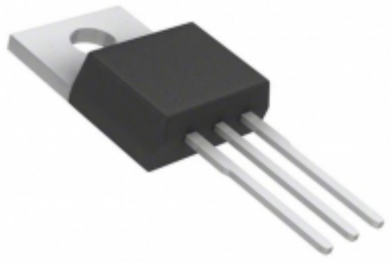








	<h2 style="color: red;">FDP040N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP040N06</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP040N06.pdf 2.FDP040N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32412 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="text-align: center;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP040N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32412 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	133nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8235pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP040N06 ist neu im Original, Suche FDP040N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP040N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP040N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP039N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>	 <p>FDP045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP038AN06AO FSC FDP038AN06AO FSC</p>	 <p>FDP040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>
 <p>FDP045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP039N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>	 <p>FDP040N08 Fairchild/ON Semiconductor FDP040N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP039N08B FSC FDP039N08B FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP020N06B	↔ FDP023N08B	⇒ FDP025N06	D FDP025N06	↔ FDP027N08B
⊣ FDP027N08B	⊗ FDP030N06	D FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102	↔ FDP032N08
⊗ FDP032N08	⊣ FDP032N08B	⊗ FDP036N10A	↔ FDP036N10A	↔ FDP038AN06AO
D FDP038AN06AO	⊗ FDP038AN06AO	⊣ FDP039N08B	⊗ FDP040N06	↔ FDP045N10A
⇒ FDP045N10A	↔ FDP047AN08	⊗ FDP047AN08A0	⊣ FDP047AN08A0	↔ FDP047AN08A0
↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08	D FDP047N08A0	⊗ FDP047N10	⊣ FDP047N10
⊗ FDP050AN06AO	D FDP050AN06AO	⇒ FDP050AN06AO	↔ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102
⊣ FDP054N10	⊗ FDP054N10	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	↔ FDP060AN08A0
⊗ FDP060N08A0	⊣ FDP060N08A0	⊗ FDP068AN08A0	D FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO
↔ FDP070AN06AO	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊗ FDP083N15A	↔ FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited